

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第1区分
 【発行日】平成26年10月2日(2014.10.2)

【公開番号】特開2012-69519(P2012-69519A)
 【公開日】平成24年4月5日(2012.4.5)
 【年通号数】公開・登録公報2012-014
 【出願番号】特願2011-183697(P2011-183697)
 【国際特許分類】

H 0 5 B 33/26 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

【F I】

H 0 5 B 33/26 Z

H 0 1 L 29/78 6 1 8 B

H 0 1 L 29/78 6 2 4

H 0 1 L 29/78 6 1 2 Z

H 0 5 B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成26年8月18日(2014.8.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

酸化物半導体を含むチャンネル形成領域を有するエンハンスメント型のトランジスタと、第1の電極及び第2の電極の間にEL層が設けられた発光素子と、を有し、前記トランジスタは、ソース電極及びドレイン電極を有し、前記ソース電極または前記ドレイン電極と前記第1の電極が電氣的に接続された半導体装置の設計方法であって、
基板の一方の面に酸化珪素膜を形成し、
前記酸化珪素膜を覆って有機膜を形成し、
前記有機膜に重水を塗布し、
前記重水を取り除き、
前記有機膜に接して導電膜を形成し、
前記酸化珪素膜中の重水素原子の濃度を測定し、
前記測定の結果、前記重水素原子が $1 \times 10^{15} \text{ atoms/cm}^3$ 以上 $1 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3$ 以下の濃度となる導電材料を選定し、
前記導電材料を前記第2の電極に適用することを特徴とする半導体装置の設計方法。